

Лекция 4

Диэлектрическая проницаемость. Электроёмкость и энергия конденсаторов

Вектор поляризации диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость среды

Для количественной характеристики поляризации диэлектрика служит специальная величина, называемая вектором поляризации. **Вектором поляризации диэлектрика** называют отношение векторной суммы электрических дипольных моментов всех молекул, заключенных в некотором объеме ΔV диэлектрика, к величине этого объема:

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_j \vec{p}_j.$$

Опыт показывает, что для не слишком сильных электрических полей вектор поляризации линейно зависит от напряженности \vec{E} электрического поля в диэлектрике. В простейшем случае изотропных диэлектриков (то есть диэлектриков, величина поляризуемости которых не зависит от направления вектора \vec{E}) эту связь можно записать в виде:

$$\vec{P} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E},$$

где ε называют **диэлектрической восприимчивостью вещества**. Если ε не зависит от координат, то такой диэлектрик называют *однородным*.

Важную роль в электростатике и электродинамике играет величина $\varepsilon = 1 + \varepsilon$, называемая (**относительной**) **диэлектрической проницаемостью вещества**. Дело в том, что оказывается справедливо следующее утверждение:

Напряженность электрического поля, создаваемого любой системой точечных зарядов или проводников с фиксированной величиной зарядов в однородном изотропном диэлектрике с диэлектрической проницаемостью ε , занимающем все пространство, где есть поле, в ε раз меньше, чем поле этой же системы зарядов и проводников в вакууме. Очевидно, что при одинаковом выборе нулевой точки потенциал любой точки поля в описанной выше ситуации при наличии диэлектрика также в ε раз меньше, чем при его отсутствии.

Замечание. Можно также доказать, что если в сформулированном выше утверждении однородный изотропный диэлектрик занимает только **часть области**, где есть поле, но эта часть **ограничена эквипотенциальной поверхностью**, то по сравнению со случаем отсутствия диэлектрика поле вне диэлектрика не изменится, а поле внутри диэлектрика уменьшится в ε раз.

Электроёмкость уединенного проводника

Рассмотрим уединенный проводник, то есть проводник расположенный достаточно далеко от всех других заряженных и незаряженных тел. Поместим на него заряд q . Он распределится по

поверхности проводника каким-то образом (так, что поле в проводнике равно нулю) и создаст во всем пространстве некоторое поле $\vec{E}(r)$, и, значит, точки проводника будут иметь некоторый одинаковый потенциал ϕ . Поместим теперь на проводник еще такой же заряд q . По теореме единственности он распределится так же, как и предыдущий заряд. В результате поле во всем пространстве удвоится, следовательно, удвоится и потенциал проводника. Из сказанного следует, что **отношение заряда уединенного проводника к его потенциалу не зависит от заряда проводника**. Это позволяет ввести понятие емкости (или просто емкости) C уединенного проводника, которая равна отношению заряда проводника к его потенциалу:

$$C = q/\phi$$

Из сказанного выше следует, что емкость уединенного проводника определяется исключительно его формой и геометрическими размерами.

Из определения следует, что единица измерения емкости

$$\frac{1 \text{ Кл}}{1 \text{ В}} = 1 \phi - \text{фарада}$$

Иными словами, емкостью в один фарад обладает такой уединенный проводник, потенциал которого при сообщении ему заряда 1 Кл равен 1 В.

Нетрудно понять, что емкость уединенного сферического проводника

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

где R – радиус сферы (т.к. $\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$).

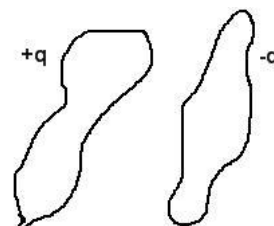
Приведенные рассуждения сохраняют свою силу и в том случае, если проводник окружен другими *незаряженными* телами. Однако наличие вблизи проводника других тел, и, в частности диэлектриков, изменяет его емкость, так как потенциал проводника зависит и от электрических полей, создаваемых зарядами, наведенными в окружающих телах в следствие электростатической индукции или поляризации. В частности, емкость проводящей сферы радиуса R , помещенной в однородный диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ϵ увеличивается в ϵ раз:

$$C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

(так как поле вокруг сферы, и, следовательно, ее потенциал, уменьшаются в ϵ раз).

Взаимная емкость двух проводников. Конденсаторы

Рассмотрим теперь систему из двух проводников *в отсутствие внешнего электрического поля*. Сообщим им равные по модулю заряды противоположного знака. В результате между проводниками возникнет разность потенциалов. Рассуждая так же, как в случае одного проводника, нетрудно понять, что отношение заряда q к разности потенциалов между



проводниками ($\phi_1 - \phi_2$) не зависит от величины q . Это отношение, точнее его модуль, называют **взаимной емкостью двух проводников**:

$$C = \left| \frac{q}{(\phi_1 - \phi_2)} \right|$$

Так как силовые линии начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных, а потенциал, как следует из его определения, уменьшается при движении по направлению силовых линий, то $|\phi_1 - \phi_2| = \phi_+ - \phi_-$, где ϕ_+ потенциал проводника, заряженного положительно, а ϕ_- – отрицательно. Поэтому:

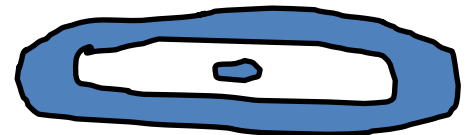
$$C = \frac{|q|}{\phi_+ - \phi_-} = \frac{q}{\phi_q - \phi_{-q}}$$

Взаимная емкость двух проводников зависит от их формы, размеров и взаимного расположения, а также от среды, в которой они находятся.

Определение. Конденсатором называется система двух разноименных заряженных равными по абсолютной величине зарядами проводников, имеющих такую форму и расположение друг относительно друга, что поле, создаваемое такой системой, сосредоточено в ограниченной области пространства. Сами проводники при этом называются обкладками конденсатора.

Емкостью конденсатора называется взаимная емкость его обкладок.

Примером конденсатора является любой полый проводник, в полости которого находится другой проводник. При этом полость между проводниками может быть заполнена каким-нибудь диэлектриком.



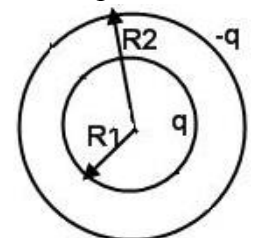
Емкость плоского и сферического конденсаторов

Наиболее часто используются плоские и сферические конденсаторы.

Сферический конденсатор состоит из двух проводящих концентрических сфер, пространство между которыми может быть заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ . Такая система создает не равное нулю поле только между обкладками, причем это поле равно полю точечного заряда, уменьшенному в ϵ раз:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r^2}$$

Соответственно $\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q}{r} + C_0$, и $\phi_+ - \phi_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0\epsilon R_2 R_1}$.



Поэтому емкость сферического конденсатора

$$C = \frac{|q|}{\phi_+ - \phi_-} = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

Видно, что при наличии диэлектрика емкость возрастает (для всех диэлектриков $\epsilon > 1$). Однако, наличие диэлектрика может уменьшать напряжение пробоя конденсатора – разность потенциалов между обкладками, при которой происходит электрический пробой слоя диэлектрика.

Часто используется также **плоский конденсатор**, состоящий из двух проводящих параллельных пластин одинаковой формы (площади S), расположенных напротив друг друга на расстоянии d , малом по сравнению с поперечными размерами пластин.

Поэтому электрическое поле между пластинами приближенно равно

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

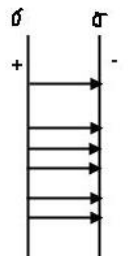
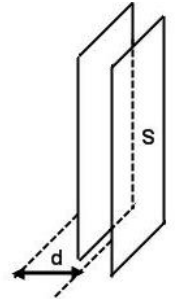
где $\sigma = \frac{|q|}{S}$ – модуль поверхностной плотности заряда на каждой из пластин.

Следовательно

$$\phi_+ - \phi_- = Ed = \frac{|q|d}{\epsilon_0 S},$$

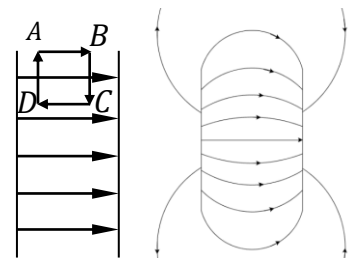
и, значит, емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}.$$



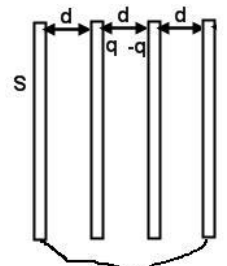
Если плоский конденсатор, обкладки которого имеют заряды фиксированной величины, полностью заполнить диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ , то поле и разность потенциалов между обкладками уменьшатся в ϵ раз, и, значит, емкость плоского конденсатора увеличится в ϵ раз.

Подчеркнём, что модель плоского конденсатора, в которой считается, что электрическое поле однородно в области между пластинами и равно нулю вне этой области, имеет ограниченную применимость. Дело в том, что электростатическое поле в такой модели является не потенциальным: работа по замкнутому контуру ABCD (см. рисунок) не равна нулю, что невозможно.



На самом деле электростатическое поле вблизи краев плоского конденсатора неоднородно и вне границ конденсатора поле не равно нулю, хоть и очень слабое. Нетрудно понять, что модель плоского конденсатора работает тем лучше, чем меньше отношение $\frac{d^2}{S}$. Однако в ряде случаев краевыми эффектами нельзя полностью пренебречь ни при каких условиях.

Пример. Четыре первоначально незаряженные одинаковые пластины поместили на расстоянии d друг от друга. Две средних пластины зарядили зарядами $+q$ и $-q$. А две крайние соединили проводником. Чему будут равны заряды на крайних пластинах ($d^2 \ll S$).

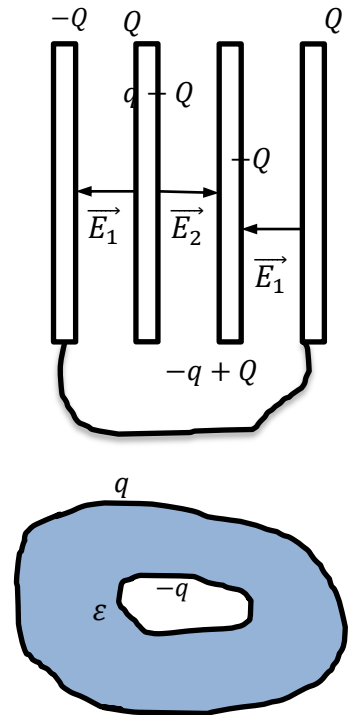


Решение. Если пользоваться моделью плоского конденсатора, то, казалось бы, крайние пластины просто “не узнают” о том, что средние пластины зарядили (поле сна-

ружи от средних пластин в этой модели равно нулю). Однако на самом деле все не так из-за описанных выше краевых эффектов. В результате правая пластина окажется заряженной положительно, а левая – отрицательно. Величину заряда найдем из условия, что крайние пластины имеют одинаковый потенциал:

$$\begin{cases} E_1 d - E_2 d + E_1 d = 0 \\ E_1 = \frac{q}{s\epsilon_0}, E_2 = \frac{q-Q}{s\epsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_2 = 2E_1 \\ q - Q = 2Q \end{cases} \Rightarrow Q = q/3$$

Расчет емкости конденсатора в случае обкладок произвольной формы является достаточно сложной задачей. Однако, и в этом случае заполнение всего пространства между обкладками диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ϵ приводит к увеличению емкости конденсатора в ϵ раз (за счет уменьшения в ϵ раз поля и, следовательно, разности потенциалов между обкладками).



Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.

Система, полученная в результате соединения пластин нескольких конденсаторов проводниками (пренебрежимо малой емкости), называется **батареей конденсаторов**. В ряде случаев батарею конденсаторов можно описать как один конденсатор емкостью C .

Если в системе двух конденсаторов с емкостями C_1 и C_2 пластины разных конденсаторов соединены попарно (батарея содержит два изолированных проводника), то такое соединение называется **параллельным**. Два (и более) параллельно соединенных конденсатора **всегда** можно описать как один конденсатор некоторой емкостью C . В этом случае общим для всех конденсаторов является разность потенциалов между обкладками $\Delta\phi$, и мы имеем:

$$q_1 = C_1 \Delta\phi, \quad q_2 = C_2 \Delta\phi.$$

Поэтому суммарный заряд, находящийся на батарее, равен

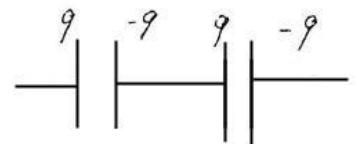
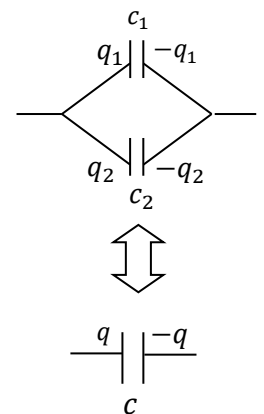
$$q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2) \Delta\phi.$$

И, следовательно, емкость батареи

$$C = \frac{q}{\Delta\phi} = C_1 + C_2.$$

Итак, **емкость батареи конденсаторов, соединенных параллельно, равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.**

Если у двух конденсаторов с емкостями C_1 и C_2 соединена одна пара пластин (батарея содержит три изолированных проводника), то такое соединение конденсаторов называется **последова-**



тельными. Последовательно соединенные конденсаторы можно рассматривать как новый конденсатор только, если соединенные между собой обкладки в целом электронеутральны!

В этом случае одинаковым для всех конденсаторов является заряд q , равный заряду батареи, и мы можем написать

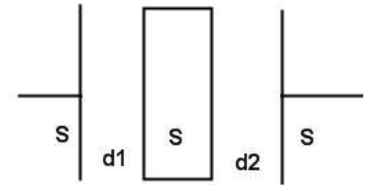
$$\Delta\phi_1 = \frac{q}{C_1}, \quad \Delta\phi_2 = \frac{q}{C_2}, \quad \Delta\phi = \frac{q}{C}.$$

Но $\Delta\phi = \Delta\phi_1 + \Delta\phi_2 = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$. Поэтому

$$\frac{1}{C} = \frac{\Delta\phi}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Итак, **при последовательном соединении конденсаторов суммируются обратные величины емкостей.** Еще раз подчеркну: это справедливо только, если полный заряд на каждой паре соединенных между собой обкладок конденсаторов равен нулю!

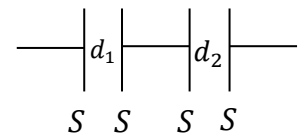
Пример А. Плоский конденсатор с пластинами площадью S , расположенными на расстоянии d_0 друг от друга, заряжен до разности потенциалов ϕ_0 . Какой станет разность потенциалов между обкладками конденсатора, если в него внести металлическую незаряженную пластину толщиной d и той же площади S ?



мы получаем батарею из двух последовательно соединенных конденсаторов, поэтому:

Решение. Емкость плоского конденсатора $C_0 = \frac{S\varepsilon_0}{d_0}$. Следовательно-

но, заряд на его обкладках $q_0 = C_0\phi_0 = \frac{S\varepsilon_0}{d_0}\phi_0$. После внесения пластины



мы получаем батарею из двух последовательно соединенных конденсаторов, поэтому:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{S\varepsilon_0} + \frac{d_2}{S\varepsilon_0} = \frac{d_1 + d_2}{S\varepsilon_0} = \frac{d_0 - d}{S\varepsilon_0}.$$

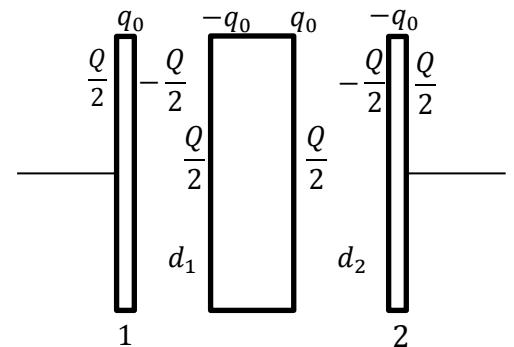
Откуда ёмкость батареи $C = \frac{S\varepsilon_0}{d_0 - d}$. Поскольку заряд

батареи q_0 , то искомая разность потенциалов:

$$\Delta\phi_1 = \frac{q_0}{C} = \frac{S\varepsilon_0}{d_0} \phi_0 \frac{d_0 - d}{S\varepsilon_0} = \frac{d_0 - d}{d_0} \phi_0.$$

Пример Б. Пусть все будет как в примере А, но внесенная пластина заряжена зарядом Q .

Решение. В этом случае, пользуясь теоремой единственности, получаем, что заряды распределятся на проводниках так, как показана на рисунке. Поэтому разность потенциалов между обкладками 1 и 2 будет равна (пользуемся принципом суперпозиции):



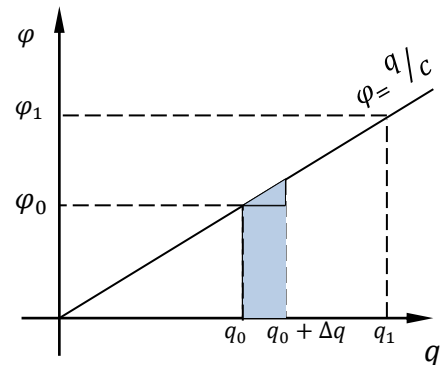
$$\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 = E_1(d_1 + d_2) + E_2(-d_1 + d_2),$$

где $E_1 = \frac{q_0}{S\varepsilon_0}$, $E_2 = \frac{Q/2}{S\varepsilon_0}$. Поскольку $q_0 = \frac{S\varepsilon_0}{d_0}\phi_0$, а $d_1 + d_2 = d_0 - d$, то окончательно имеем:

$$\Delta\phi = \frac{d_0 - d}{d_0}\phi_0 + \frac{Q}{2S\varepsilon_0}(d_2 - d_1).$$

Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля

Чтобы зарядить конденсатор, необходимо перенести свободные заряды с одной пластины на другую. Электростатическое поле, возникающее при этом между пластинами, будет действовать на переносимые заряды, препятствуя процессу переноса, т.е. совершая отрицательную работу и увеличивая потенциальную энергию взаимодействия разделенных зарядов, то есть потенциальную энергию конденсатора. Пусть обкладки конденсатора уже заряжены зарядами q_0 и $-q_0$ ($q_0 > 0$). Пусть емкость конденсатора C , тогда разность потенциалов между его обкладками $\phi_0 = \phi_+ - \phi_- = q_0/C$. Следовательно, при переносе очень малого положительного заряда Δq с отрицательно заряженной обкладки на положительно заряженную обкладку, электрическое поле совершит работу $\Delta A = -\Delta q\phi_0$, а потенциальная энергия конденсатора увеличится на $\Delta W = \Delta q\phi_0$. Если построить график зависимости разности потенциалов между обкладками конденсатора от величины его заряда q , то ΔW будет равно площади заштрихованной области под графиком (см. рисунок), умноженной на соответствующий масштабный множитель. Отсюда ясно, что при перемещении с одной первоначально не заряженной пластины конденсатора емкости C на другую пластину некоторого заряда q_1 , электрическое поле совершит работу



а энергия конденсатора W изменится на величину

$$A = -\frac{1}{2}\phi_1 q_1 = -\frac{q_1^2}{2C} = -\frac{C\phi_1^2}{2},$$

а энергия конденсатора W изменится на величину

$$\Delta W = \frac{1}{2}q_1\phi_1 = \frac{q_1^2}{2C} = \frac{C\phi_1^2}{2}.$$

Полагая энергию незаряженного конденсатора равной нулю, получим, что энергия конденсатора емкости C , заряженного зарядом q до разности потенциалов ϕ равна

$$W = \frac{1}{2}q\phi = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\phi^2}{2}.$$

С другой стороны, энергию заряженного конденсатора можно рассматривать как энергию электростатического поля, заключенного между его обкладками.

Рассмотрим плоский конденсатор с пластинами площади S , расположенными на расстоянии d . Пусть пространство между пластинами заполнено диэлектриком с диэлектрической про-

нищаемостью ε , и пластины заряжены зарядом q . Тогда между пластинами существует электростатическое почти однородное поле напряженностью

$$E = \frac{q}{S\varepsilon_0\varepsilon}.$$

А разность потенциалов между пластинами

$$\phi = Ed.$$

Выражая из предпоследней формулы q через E и подставляя выражения для q и ϕ в формулу для энергии заряженного конденсатора (и, следовательно, для энергии электростатического поля), получим:

$$W = \frac{1}{2}(S\varepsilon_0\varepsilon E)(Ed) = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon E^2V$$

где $V \equiv Sd$ – объем области между обкладками конденсатора. Отсюда очевидно, что плотность энергии электрического поля, то есть его энергия в единице объема, определяется формулой:

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon E^2.$$

Оказывается, что полученная формула имеет общий характер и справедлива для плотности энергии любого (не только однородного) электрического поля.